Guide aux Auteurs pour les JPCNFM’2025

L. Pichona, H. Lhermitea, A.C. Salaüna , O. Bonnaudb

a IETR et pôle CNFM de Rennes (CCMO), Université de Rennes, Rennes, France

b IETR (Université de Rennes) et GIP-CNFM, Grenoble, France

Contact email : herve.lhermite@univ-rennes.fr

Ce manuscrit doit débuter par un résumé d’une longueur maximale de 200 mots, la police de caractère étant Times New Roman 12, ligne espacée d’un simple espace et de largeur 11,5 cm (4,5 pouces!), et centré. Ne pas introduire de retrait en début de paragraphe dans ce cas. Ne pas introduire de retour à la ligne dans le résumé. Le résumé se situe en début de papier après la présentation du titre, des auteurs et de leurs affiliations. Pour avoir un ordre de grandeur de la longueur du résumé, ce résumé comporte 94 mots.

## Titre de paragraphe

Commencer votre article ici en style « paragraphe ». Tous les paragraphes doivent avoir le même retrait. Ce paragraphe comporte les caractéristiques types en termes de police, de taille, de retrait et d’interligne. Toutes les références sont numérotées de façon consécutive avec le numéro apparaissant entre parenthèses comme à la fin de cette phrase (1).

Pour utiliser ce guide aux auteurs ou *template*, remplacer directement le texte de ce *template* par votre texte. A la fin du paragraphe complet, introduire un saut de ligne.

Dans l’organisme de rattachement des auteurs, mentionner le pôle CNFM concerné.

1. Sous-titre paragraphe

Le paragraphe après le sous-titre a les mêmes caractéristiques que celui après un titre. Il suffit de recopier le formatage du paragraphe précédent au cas où il aurait été perdu ou de confirmer le format « paragraphe » apparaissant dans la liste de la barre d’outils. A la fin du sous-paragraphe, introduire un saut de ligne, comme dans le cas d’un paragraphe.

Les figures sont positionnées dans le texte comme montré ci-dessous. Toutes les figures comportent une légende. Celle-ci doit donner un minimum d’information sur l’intérêt de sa présentation. Par exemple, pas uniquement « caractéristique courant-tension » (ce qui est normalement évident), mais « tracé des caractéristiques courant-tension des transistors MOSFET fabriqués en salle blanche par les étudiants en master international spécialisé en microtechnologies et microsystèmes ». Dans le cas d’une vidéo, la légende donne en une ou deux phrases l’objet de la vidéo.

REMPLACER CE TEXTE PAR UNE FIGURE OU UN GRAPHE

Ceci est le style retenu pour les légendes des figures. Centrer le texte si celui-ci est plus court qu’une ligne complète. S’assurer que la légende se positionne sur la même page que la figure. Eviter que la légende se répartisse sur deux pages. Dans le cas d’une vidéo, ne pas oublier de mettre le lien.

1. Equations et tableaux

Les équations doivent être écrites centrées et séparées du texte des paragraphes par une ligne au-dessus et une ligne en-dessous. Elles sont numérotées consécutivement tout au long de l’article, les numéros apparaissant entre crochets comme indiqué ci-après, alignement à droite.

A + B - (c + d) = xy \* z + (q2 + 3) [1]

Tous les tableaux doivent s’intercaler avec les paragraphes. Ils ont la même largeur maximale que le texte. Tous les tableaux sont numérotés de manière consécutive tout au long de l’article avec des chiffres romains. Le titre apparait au-dessus du tableau comme montré ci-dessous.

|  |
| --- |
| 1. C’est le titre.
 |
| Titre Colonne, ici | Titre Colonne, ici | Titre Colonne, ici |
| Nom de la rangée, ici | X | x |
| Nom de la rangée, ici | X | x |
| Nom de la rangée, ici | X | x |

Remerciements

Placer les remerciements à la fin du texte et juste avant les références bibliographiques. Le style correspond à celui d’un paragraphe normal. Ne pas oublier de mentionner, quand c’est le cas, du soutien du GIP et donc de la DGESIP, et éventuellement, du projet INFORISM, référence (9), si le TP a été cofinancé dans le cadre de celui-ci.

Références

Les citations complètes doivent apparaitre à la fin de l’article. Utiliser le style qui apparaît dans les exemples ci-dessous.

1. J. Doe and R. Hill, Title, *J. Electrochem. Soc.,* 152, H1902 (2005).
2. R. Smith, Title, *Electrochem. Solid-State Lett.*, **10**, A1 (2007).
3. E. Gaura and R. M. Newman, Title*, ECS Trans.*, **4**(1), 3 (2006).
4. D. Warren and J. M. Woodall, in *Semiconductor Cleaning Technology/1989*, J. Ruzyllo and R. E. White, Editors, PV 90-9, p. 371, The Electrochemical Society Proceedings Series, Pennington, NJ (1990).
5. F. P. Fehlner, *Low Temperature Oxidation: The Role of Vitrous Oxides*, p. 23, Wiley Interscience, New York (1986).
6. N. J. DiNardo, in *Metallized Plastics 1*, K. L. Mittal and J. R. Susko, Editors, p. 137, Plenum Press, New York (1989).
7. ACSIEL Alliance Electronique: website: *https://www.acsiel.fr(Accès juillet 2025)*
8. O. Bonnaud *et al*., Microelectronics Online course : [*https://microelectronique.univ-rennes1.fr/index21.html*](https://microelectronique.univ-rennes1.fr/index21.html)
9. French national program (France 2030): INFORISM (Engineering of Education Innovative and Strategic in Microelectronics), AMI-CMA, ANR-23-CMAS-0024, June 2024, htpps://www.cnfm.fr
10. GIP-CNFM: Groupement d’Intérêt Public - Coordination Nationale pour la formation en Microélectronique et en nanotechnologies. Website: <http://wwww.cnfm.fr> (last access June 2025)